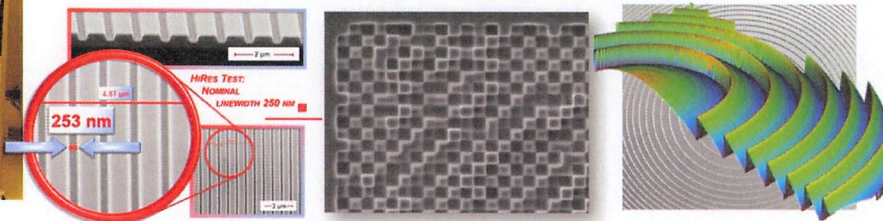


# 産総研 NPF R4年度新規導入装置

## レーザー描画装置〔DWL66+〕 (ハイデルベルグ社)



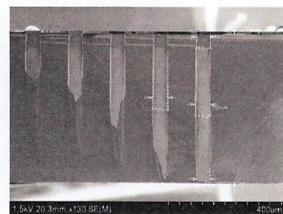
- ・ 最小線幅：0.5  $\mu\text{m}$  (L&S)  
0.3  $\mu\text{m}$  (孤立)
- ・ グレースケール:1000階調



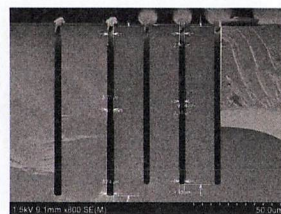
## Si深堀エッチング装置〔Cobra〕 (Oxford Instr.)



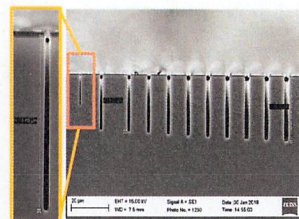
- ・ ボッシュプロセス
- ・  $\text{CF}_4$ ,  $\text{CHF}_3$ ,  $\text{SF}_6$ ,  $\text{C}_4\text{F}_8$ ,  $\text{O}_2$



スルーホール  
AR:10



3  $\mu\text{m}$  トレンチ  
AR:30



0.37  $\mu\text{m}$  トレンチ  
AR:37

## XPS付きALD\_3号機 (Oxford Instr.)



- ・ 材料ガス：8系統
- ・ 高濃度オゾン低温サーマルALD)
- ・ 重水、 $\text{D}_2$ ガス、 $\text{ND}_3$ ガス
- ・ in-situ XPS

## 窒化膜用ALD\_4号機 (Oxford Instr.)

- ・ 材料ガス：3系統  
(将来的に塩素系材料、個体材料)
- ・  $\text{D}_2$ ガス、 $\text{ND}_3$ ガス
- ・ in-situ 分光エリプソ

電子メール: [tia-npf-ml@aist.go.jp](mailto:tia-npf-ml@aist.go.jp)